|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Перв. примен* | *ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.001* | *Форма* | *Зона* | *Поз.* | | *Обозначение* | | | | *Наименование* | | | | | *Кол.* | *Примечание* | |
|  |  |  | |  | | | | *Документация* | | | | |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  | | | | |  |  | |
| *А3* |  |  | | *ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.001 СБ* | | | | *Сборочный чертёж* | | | | | *1* |  | |
| *A1* |  |  | | *ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.001 Э1* | | | | *Схема электрическая структурная* | | | | | *1* |  | |
| *А3* |  |  | | *ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.001 Э3* | | | | *Схема электрическая* | | | | | *1* |  | |
|  |  |  | |  | | | | *принципиальная* | | | | |  |  | |
| *А4* |  |  | | *ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.001 ПЭ* | | | | *Перечень элементов* | | | | | *1* |  | |
| *А3* |  |  | | *ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.001 Э0* | | | | *Измерительный стенд* | | | | | *1* |  | |
|  |  |  | | *ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.001 ПД1* | | | | *Сравнение моделирования и* | | | | | *1* |  | |
|  |  |  | |  | | | | *Экспериментальных данных* | | | | |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  | | | | |  |  | |
|  | |  |  |  | |  | | | | *Детали* | | | | |  |  | |
| *А3* |  | *1* | | *ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.002 ПП* | | | | *Плата печатная* | | | | | *1* |  | |
|  |  | *2* | |  | | | | *Радиаторы для VT1, VT4* | | | | | *2* |  | |
| *Подп. и дата* |  |  |  | *3* | |  | | | | *Радиатор для VT5* | | | | | *1* |  | |
|  |  |  | |  | | | |  | | | | |  |  | |
|  |  |  | |  | | | | *Диоды* | | | | |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  | | | | |  |  | |
|  |  | *4* | |  | | | | *ZPD12-DIO* | | | | | *1* | *VD1* | |
|  |  |  | |  | | | | *(Diotec Semiconductor, Германия)* | | | | |  |  | |
|  |  | *5* | |  | | | | *1N4007* | | | | | *4* | *VD1, VD3, VD4, VD5* | |
|  |  |  | |  | | | | *(Diotec Semiconductor, Германия)* | | | | |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  | | | | |  |  | |
|  |  |  | |  | | | | *Конденсаторы* | | | | |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  | | | | |  |  | |
|  |  | *6* | |  | | | | *Конденсатор электролитический* | | | | | *2* | *C1, C12* | |
|  |  |  | |  | | | | *TRK221M2AJ20 220мкФ 100В 20%* | | | | |  |  | |
|  |  |  | |  | | | | *(Jamicon, США)* | | | | |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | *ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.001 СП* | | | | | | | | |
|  |  | |  | |  |  |
| *Изм* | *nucm* | | *N докум.* | | *Подпись* | *Даmа* |
| *Инв. N подл.* |  | *Разраб.* | | | *Дорунц Ш.А.* | |  |  | *Усилитель низких частот*  *Спецификация* | | *Лит.* | | | *Лист* | | | *Листов* |
| *Пров.* | | | *Семенцов С.Г* | |  |  |  |  |  | *1* | | | *4* |
|  | | |  | |  |  | *МГТУ им. Н.Э. Баумана Кафедра ИУ4*  *Группа ИУ4-53Б* | | | | | | |
| *Н. контр.* | | |  | |  |  |
| *Утв.* | | |  | |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Перв. примен* | ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.001 | *Форма* | *Зона* | *Поз.* | | *Обозначение* | | | | *Наименование* | *Кол.* | *Примечание* | |
|  |  | *7* | |  | | | | *Конденсатор металлоплёночный* | *2* | *C2, C13* | |
|  |  |  | |  | | | | *B32529C0105K000 1мкФ 63В 10%* |  |  | |
|  |  |  | |  | | | | *(EPCOS, Германия)* |  |  | |
|  |  | *8* | |  | | | | *Конденсатор керамический* | *1* | *C3* | |
|  |  |  | |  | | | | *RDER71H224K 220нФ 50В 10%* |  |  | |
|  |  |  | |  | | | | *(Murata Electronics, Япония)* |  |  | |
| *Справ* |  |
|  |  | *9* | |  | | | | *Конденсатор электролитический* | *1* | *C4* | |
|  |  |  | |  | | | | *B41851A6227M000 220мкФ 50В 20%* |  |  | |
|  |  |  | |  | | | | *(EPCOS, Германия)* |  |  | |
|  |  | *10* | |  | | | | *Конденсатор керамический* | *1* | *C5* | |
|  |  |  | |  | | | | *RDER71H474K 470нФ 50В 10%* |  |  | |
|  |  |  | |  | | | | *(Murata Electronics, Япония)* |  |  | |
|  |  | *11* | |  | | | | *Конденсатор электролитический* | *2* | *C6, C11* | |
|  | |  |  |  | |  | | | | *TKR100M1ED11M 10мкФ 25В 20%* |  |  | |
|  |  |  | |  | | | | *(Jamicon, США)* |  |  | |
|  |  | *12* | |  | | | | *Конденсатор керамический* | *1* | *C7* | |
| *Подп. и дата* |  |
|  |  |  | |  | | | | *RDE5C1H221J 220пФ 50В 10%* |  |  | |
|  |  |  | |  | | | | *(Murata Electronics, Япония)* |  |  | |
|  |  | *13* | |  | | | | *Конденсатор пленочный* | *1* | *C8* | |
|  |  |  | |  | | | | *FKP2D001001D00 100пФ 100В 10%* |  |  | |
| *Инв. N дубл.* |  |  |  |  | |  | | | | *(Wima, Германия)* |  |  | |
|  |  |  |  | *14* | |  | | | | *Конденсатор керамический* | *1* | *C9* | |
|  |  |  | |  | | | | *1800пФ X7R 10% (Китай)* |  |  | |
| *Подп. и дата* |  |
|  |  | *15* | |  | | | | *Конденсатор электролитический* | *1* | *C10* | |
|  |  |  | |  | | | | *WLR471M1AE15 470мкФ 10В 20%* |  |  | |
|  |  |  | |  | | | | *(Jamicon, США)* |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | | | *Разъёмы* |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  |  | *16* | |  | | | | *Клеммник разъёмный* | *1* | *XS1* | |
|  |  |  | |  | | | | *15EDGRC-3.81-03P (Degson, Китай)* |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | *ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.001 СП* | | | | *лист* |
|  |  | |  | |  |  |
| *2* |
| *Из* | *лист* | | *N докум.* | | *Подпись* | *Дата* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Перв. примен* | ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.001 | *Форма* | *Зона* | *Поз.* | | *Обозначение* | | | | *Наименование* | *Кол.* | *Примечание* | |
|  |  | *17* | |  | | | | *Клеммник разъёмный* | *1* | *XS2* | |
|  |  |  | |  | | | | *15EDGRC-3.81-02P (Degson, Китай)* |  |  | |
|  |  | *18* | |  | | | | *Гнездо стерео 3.5мм ST-025* | *1* | *XS3* | |
|  |  |  | |  | | | | *(Dragon City Industries, Китай)* |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | | | *Резисторы* |  |  | |
| *Справ* |  |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  |  | *19* | |  | | | | *Резистор углеродистрый* | *1* | *R1* | |
|  |  |  | |  | | | | *CF-100 1 Вт 2,2 кОм 5% (Тайвань)* |  |  | |
|  |  | *20* | |  | | | | *Резистор углеродистрый* | *2* | *R2, R3* | |
|  |  |  | |  | | | | *CF-100 1 Вт 1 кОм 5% (Тайвань)* |  |  | |
|  |  | *21* | |  | | | | *Резистор проволочный цементный* | *2* | *R4, R6* | |
|  |  |  | |  | | | | *SQP 5 Вт 0,22 Ом 5% (Тайвань)* |  |  | |
|  | |  |  | *22* | |  | | | | *Резистор углеродистрый* | *1* | *R5* | |
|  |  |  | |  | | | | *CF-25 0,25 Вт 2,7 кОм 5% (Тайвань)* |  |  | |
|  |  | *23* | |  | | | | *Резистор углеродистый* | *1* | *R7* | |
| *Подп. и дата* |  |
|  |  |  | |  | | | | *CF-25 0,25 Вт 8,2 кОм 5% (Тайвань)* |  |  | |
|  |  | *24* | |  | | | | *Резистор углеродистый* | *1* | *R8* | |
|  |  |  | |  | | | | *CF-25 0,25 Вт 22 кОм 5% (Тайвань)* |  |  | |
|  |  | *25* | |  | | | | *Резистор углеродистый* | *1* | *R9* | |
| *Инв. N дубл.* |  |  |  |  | |  | | | | *MO-200 2 Вт 1 Ом 5% (Тайвань)* |  |  | |
|  |  |  |  | *26* | |  | | | | *Резистор проволочный цементный* | *1* | *R10* | |
|  |  |  | |  | | | | *SQP 10 Вт 0,33 Ом 5% (Тайвань)* |  |  | |
| *Подп. и дата* |  |
|  |  | *27* | |  | | | | *Резистор углеродистый* | *1* | *R11* | |
|  |  |  | |  | | | | *CF-25 0,25 Вт 100 Ом 5% (Тайвань)* |  |  | |
|  |  | *28* | |  | | | | *Резистор углеродистый* | *1* | *R12* | |
|  |  |  | |  | | | | *CF-25 0,25 Вт 750 Ом 5% (Тайвань)* |  |  | |
|  |  | *29* | |  | | | | *Резистор углеродистый* | *1* | *R13* | |
|  |  |  | |  | | | | *CF-25 0,25 Вт 3 Ом 5% (Тайвань)* |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | *ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.001 СП* | | | | *лист* |
|  |  | |  | |  |  |
| *3* |
| *Из* | *лист* | | *N докум.* | | *Подпись* | *Дата* |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Перв. примен* | ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.001 | *Форма* | *Зона* | *Поз.* | | *Обозначение* | | | | *Наименование* | *Кол.* | *Примечание* | |
|  |  |  | |  | | | | *Транзисторы* |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  |  | *30* | |  | | | | *TIP142* | *1* | *VT1* | |
|  |  |  | |  | | | | *(STMicroelectronics, Франция)* |  |  | |
|  |  | *31* | |  | | | | *BC556B* | *2* | *VT2, VT3* | |
|  |  |  | |  | | | | *(Diotec Semiconductor, Германия)* |  |  | |
| *Справ* |  |
|  |  | *32* | |  | | | | *TIP147* | *1* | *VT4* | |
|  |  |  | |  | | | | *(STMicroelectronics, Франция)* |  |  | |
|  |  | *33* | |  | | | | *BD241C* | *1* | *VT5* | |
|  |  |  | |  | | | | *(STMicroelectronics, Франция)* |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  | |  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
| *Подп. и дата* |  |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
| *Инв. N дубл.* |  |  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  |  |  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
| *Подп. и дата* |  |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  |  |  | |  | | | |  |  |  | |
|  |  | |  | |  |  | *ИУ4.11.03.03.23.05.52.09.001 СП* | | | | *лист* |
|  |  | |  | |  |  |
| *4* |
| *Из* | *лист* | | *N докум.* | | *Подпись* | *Дата* |